

КП7129А

КРЕМНИЕВЫЙ ЭПИТАКСИАЛЬНО-ПЛАНАРНЫЙ ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР

АДБК 432140.110 ТУ

КРЕМНИЕВЫЕ ЭПИТАКСИАЛЬНО-ПЛАНАРНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ С ИЗОЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ, ОБОГАЩЕНИЕМ N-КАНАЛА И ВСТРОЕННЫМ ОБРАТНОСМЕЩЕННЫМ ДИОДОМ. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ДРАЙВЕРАХ, БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ НАПРЯЖЕНИЯ, ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ АНАЛОГОВЫХ СХЕМАХ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОЙ АППАРАТУРЕ И ДРУГОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ.

* Зарубежный аналог - **SSU1UN60**

* Изготавливается в корпусе **КТ-28-2 (ТО-220АВ)**.

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Предельные значения
Напряжение сток-исток	Уси max	В	600
Напряжение затвор-исток	Узи max	В	±20
Постоянный ток стока	Ис max	А	1,2
Импульсный ток стока	Ис и max	А	4,8
Рассеиваемая мощность	Рmax	Вт	40
Прямой ток диода	Ипр. max	А	1,2
Температура перехода	Тпер	°С	150



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Токр.ср.=25°С)

Параметры	Обозначение	Ед. измерения	Режимы измерения	Min	Max
Пороговое напряжение	Узи пор	В	Ис=250мкА, Узи=Уси	2,0	4,0
Ток стока	Ис	А	ti ≤300мкс. Q ≥50 Уси=18В, Узи=10В	1,2	
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии	Рси отк	Ом	ti ≤300мкс. Q ≥50 Ис=0,6А, Узи=10В		11,5
Остаточный ток стока	Ис ост	мкА	Уси=Уси max, Узи=0		10
Ток утечки затвора	Из уг	нА	Уси=0, Узи=±20В	-100	+100
Крутизна ВАХ	S	А/В	ti ≤300мкс. Q ≥50 Уси=25В, Ис=0,6А	0,6	
Прямое напряжение диода	Упр	В	ti ≤300мкс. Q ≥50 Ис=-1,2А, Узи=0В		1,4
Время включения/выключения	* твкл/ твыкл	нс	ti ≤300мкс. Q ≥50, Уси=300В, Ис=1,2А, RГ=50 Ом,		80/85
Тепл. сопрот. переход-корпус	* Rt п-к	°С/Вт			3,13
Входная емкость	* С11и	пФ	Узи=0, Уси=25В, f=1МГц		280
Выходная емкость	* С22и	пФ	Узи=0, Уси=25В, f=1МГц		40
Проходная емкость	* С12и	пФ	Узи=0, Уси=25В, f=1МГц		15

* Справочные параметры

220108, г.Минск, ул. Корженевского,16 УП "Завод Транзистор"

Отдел маркетинга: т/ф (10-37517) 212-59-32

E-mail: market@transistor.com.by <http://www.transistor.by>